

광전자 분광 기술을 이용한 유기물질 계면 연구

박용섭

1. 서론

최근 들어 새로운 기능을 가진 신소재들과 나노 물질들이 개발되면서 이들의 다양한 특성을 평가하는 기술의 중요성이 그 어느 때보다 부각되고 있다. 일반적으로 물질이나 재료의 특성을 평가하는 방법은 그 물질로 이루어진 시료에 외부에서 자극을 가할 때 시료가 어떻게 반응하는가를 관찰하는 것으로 이루어진다. 가해주는 외부자극은 전압, 전류, 열, 압력, 빛, 전자빔, 이온빔 등이 될 수 있을 것이며, 여러 종류의 자극의 조합도 가능할 것이다. 가해진 자극에 대한 시료의 반응도 온도 변화, 부피 변화, 빛, 전자빔, 이온빔의 방출, 등이 될 수 있다. 미세구조의 연구에 많이 사용되는 투과전자현미경(TEM)은 고전압에 의해서 가속된 전자빔을 시료에 쏘아 보내서, 시료를 투과한 전자빔의 방출을 관찰하여 시료의 미세 원자배열 구조를 알아내는 것이다. 또한 PL(photoluminescence) 기술은 시료에 단일 파장의 빛을 쬐어 주었을 때 방출되는 시료 고유의 빛을 측정하여 시료의 발광 특성을 알아내는 기술이다. 이들과 유사하게 여기서 다루는 광전자분광(photoemission spectroscopy, PES) 기술은 단일 파장의 빛을 시료에 쬐일 때 광전효과(photoelectric effect)에 의해서 튀어나오는 전자의 세기, 에너지 등의 특성을 조사하여 시료의 전자구조에 관련된 성질을 알아내는 기술이다.

광전자분광 기술은 전통적으로 X-선 영역의 단일 파장 빛을 사용하는 X-선 광전자 분광(X-ray photoelectron spectroscopy, XPS)과 UV 영역의 빛을 사용하는 UV 광전자 분광(ultraviolet photoelectron spectroscopy, UPS)으로 나눌 수 있다. XPS는 1000~1500 eV 정도의 에너지를 가지는 X-선을 사용하여 주로 시료 내부 원자의 core level에서 방출되는 전자를 분석하여, 시료에 있는 원소의 종류, 화학상태, 농도 등을 알아내는 기술로서, 많은 상용 장비가 판매되고 있고 분석 방법이나 사용법 등이 널리 알려져 있다. UPS는 10~20 eV 정도의 극자외선(extreme UV) 영역의 빛을 사용하여 시료의 가전자(valence electron) 영역의 전자를 방출하도록 하여, 화학결합에 직접 참여하는 전자들이 고체 내에서 가질 수 있는 다양한 상태를 알 수 있도록 해 주는 기술이다. 특히 소위 각분해 UPS(angle-resolved UPS, ARUPS/ARPES)는 단결정 시료의 밴드구조를 직접 측정할 수 있기 때문에 이러한 측정이 물질의

특이한 성질을 이해하는데 중요한 요인이 되는 고온 초전도체나 거대 자기저항 물질 등에서 물리적 성질을 파악하는데 지대한 공헌을 하고 있다.

대부분의 고분자나 유기 물질의 경우 정상적인 상태가 비결정질일 뿐만 아니라 많은 경우 전기적 부도체이기 때문에 전자구조적 성질을 아는 것이 그 물질의 특성을 파악하는데 크게 중요하지 않았고, 실험 과정에서 방출되는 전자에 의해서 발생하는 시료내의 양전하가 부도체 시료에서 중화되기 힘들 뿐만 아니라 얻어진 스펙트럼의 해석이 간단하지 않아서 널리 사용되지 못하고 있었다. 하지만, 최근 들어서 전도성 고분자를 비롯하여, 유기 EL 소자에 사용되는 고분자 및 저분자 유기물질, 그리고 유기 반도체 소자나 유기 태양전지의 경우에는 사용되는 물질은 그 전기전도성이 크게 나쁘지 않을 뿐만 아니라, 전자구조와 관련된 각종 성질들이 소자의 특성에 결정적인 영향을 미치기 때문에 UPS를 이용한 전자구조 관련 측정의 중요성이 급격히 부각되고 있다. 특히, XPS 및 UPS는 시료의 표면에서 약 10 nm 이내의 깊이 영역만을 측정할 수 있는 표면 민감성으로 인해서 다양한 유기 소자에서 필연적으로 나타나는 유기/금속 혹은 유기/유기 등의 다양한 계면의 전자구조변화를 민감하게 측정할 수 있다는 점이 커다란 이점으로 작용하고 있다. 여기서는 먼저 다음 절에서 XPS와 UPS를 몽땅 그려서 광전자 분광기술의 원리에 대해서 설명하고, UPS의 측정 대상이 되는 여러 물질들 중에서 특히 유기 EL 소자와 관련된 물질들을 간단히 소개한 후, UPS와 XPS를 사용하여 다양한 표면 및 계면의 전자구조를 측정한 사례들을 들어 본다. 이어서, UPS와 연관된 다른 측정기술들을 간단히 소개하고, 결론을 맺도록 한다.



박용섭

1986 서울대학교 물리교육과(학사)
 1988 서울대학교 물리학과(석사)
 1994 Northwestern University(박사)
 1994~ University of Rochester(Post-Doc.)
 1996
 1997~ 한국표준과학연구원(선임연구원/
 책임연구원/그룹리더)
 2006
 2006~ 경희대학교 이과대학 물리학과(조교수)
 현재

Photoemission Spectroscopy for Organic Electronic Materials Interface

경희대학교 이과대학 물리학과(Yongsup Park, Department of Physics, Kyung Hee University, 1 Hoegi-dong, Dong-daemun, Seoul 130-701, Korea) e-mail: parky@khu.ac.kr

2. 광전자 분광기술

2.1 원리

앞서 언급한 것처럼 광전자 분광기술은 단일 파장의 빛을 시료에 쬐어서 시료 표면 근처에서 광전효과에 의해서 튀어나오는 전자의 세기를 운동에너지에 따라 분석하여 시료의 전자상태를 알아내는 기술이다. 광전효과는 1887년 Hertz에 의해서 발견되었는데, 당시의 물리학 지식으로는 광전효과를 제대로 이해할 수 없었다. 이는 10년 후인 1897년이 되어서야 전하를 띤 입자로서의 전자가 발견되었기 때문이기도 하고, 광전효과의 대표적인 특징인 일정한 파장보다 긴 파장의 빛을 쬐이면 전혀 효과가 나타나지 않는 현상은 빛의 양자역학적 이론이 확립되기 전에는 이해할 수 없는 현상이었기 때문이었다. 1900년에 Planck에 의해서 양자이론이 제창된 후 1905년에 이르러서야 Einstein에 의해서 광전효과를 양자역학적으로 제대로 이해할 수 있게 되었다.

그림 1에 보인 것은 XPS와 UPS 과정을 나타내는 개략도이다. 일반적인 고체 시료는 화학결합을 하고 있는 한 종류 이상의 원자로 이루어져 있다. 이들 원자에는 화학결합에 직접 참여하며 결정상태의 고체인 경우 밴드를 이루면서 개별 원자에 속박되지 않고 고체 전체에 퍼져있는 가전자(valence electron)와, 화학결합에 직접 참여하지 않으면서 개별 원자에 속박되어 있는 코어전자(core electron)가 존재한다. 가전자들은 밴드를 이루면서 일정한 에너지 폭을 가지고 존재하게 되며, 코어전자들은 이산적(discrete)인 값을 가지는 일정한 에너지 상태에 존재한다. 이러한 시료에 $h\nu$ ($\hbar\omega$)의 에너지를 가지는 빛을 쬐이면, 에너지와 운동량 보존 법칙을 만족하면서 전자가 운동에너지를 얻게 된다. 이때 시료를 떠나서 튀어나가는 전자의 운동에너지의 값은 다음과 같이 주어진다.

$$E_{\text{kin}} = \hbar\omega - \phi - |E_b| \quad (1)$$

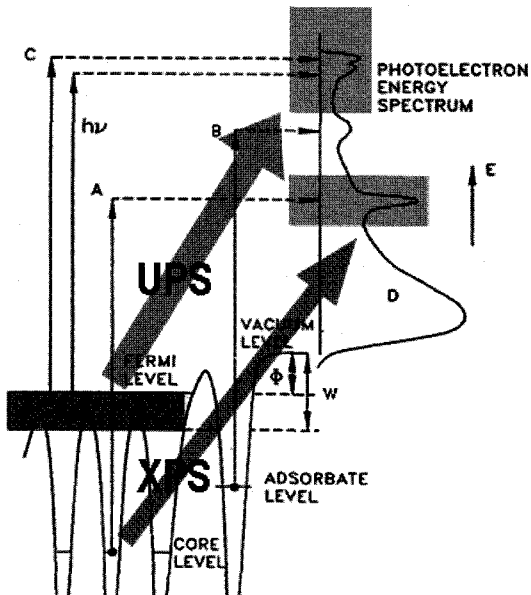


그림 1. XPS 및 UPS 스펙트럼 측정 과정에서 일어나는 광전자 방출을 보이는 개략도. 에너지 보존 법칙에 의해서 고체 속에 있는 전자의 속박에너지(binding energy)를 튀어나오는 전자의 운동에너지(kinetic energy)를 측정함으로써 알 수 있다.

여기서 E_{kin} 는 튀어나오는 전자의 운동에너지, ϕ 는 시료의 일함수(work function), E_b 는 튀어나오는 전자가 시료에 속박되어 있을 때의 속박에너지(binding energy)이다. 외부에서 전자에너지 분석기(electron energy analyzer)를 이용하여 튀어나오는 전자의 운동에너지에 따른 세기를 측정하면 시료 내부에 있는 전자들의 속박 에너지에 따른 상태 밀도(density of state)를 알 수 있다. 이러한 스펙트럼을 에너지 분포곡선(energy distribution curve, EDC)이라고 한다. 그림 1에서 볼 수 있는 것처럼 이산적인 값을 가지는 코어준위에 존재하는 전자들은 EDC에서 피크로 나타나며, 일정한 폭을 가지고 있는 가전자대에 있는 전자들은 상태 밀도에 비례하는 세기의 스펙트럼이 나타나게 된다.

광전효과에 의해서 일정한 운동에너지를 가지게 되는 전자들은 사용된 빛이 시료 안으로 투과해 들어가는 수 micron 깊이 안에서는 어디서나 만들어지게 되지만 시료 내부를 거쳐서 표면까지 빠져 나오는 동안 다양한 과정을 통해서 운동에너지의 일부를 잃을 수 있다. 통상 10~1000 eV 범위의 운동에너지를 가지는 전자는 고체를 투과할 때 다른 전자들과 충돌하여 이들을 여기시키거나 원자핵과 충돌하여 격자진동을 여기 시키면서 에너지를 잃는데, 이러한 과정을 비탄성 충돌(inelastic scattering)이라고 한다. 이 과정을 거친 전자는 광전자 분광 EDC에서 유용한 정보를 가지고 있지 못하고 배경(background)으로 작용한다. 따라서 우리가 EDC에서 피크 등으로 의미를 가지는 전자들은 시료의 표면 근처에서 튀어나온 것에 국한된다. 이는 광전자 분광기술이 표면에만 민감하다는 의미이다. 그림 2에 보인 것이 이러한 과정이다. 일반적으로 λ_0 의 세기의 전자가 에너지 E 를 가지고 어떤 물질을 x 만큼 투과하면 비탄성 충돌에 의해서 줄어드는 세기 I 는 다음과 같이 표시된다.

$$I = I_0 e^{-x/\lambda} \quad (2)$$

여기서 $\lambda(E)$ 는 튀어나오는 전자의 운동에너지와 시료를 이루는 물질에 의존하는 양으로써 비탄성 평균 자유행로(inelastic mean free path, IMFP)라고 한다. 대부분의 고체 물질에서 IMFP는 수 nm에 불과하기 때문에 그림 2에 보인 것처럼 광전자 분광기술은 극히 표면에만 민감한 탐침(probe) 실험방법이라고 할 수 있다. 그림 3에 보인 것은 여러 가지 물질을 투과하는 전자의 경우 운동에너지와 IMFP의 관계를 나타낸 것이다. 상당히 벗어나는 부분도 많이 있지만 대체적으로 물질의 종류에 무관하게 하나의 곡선에 근사적으로 맞아 떨어지는데, 이 곡선을 universal curve라고 하고, 전자

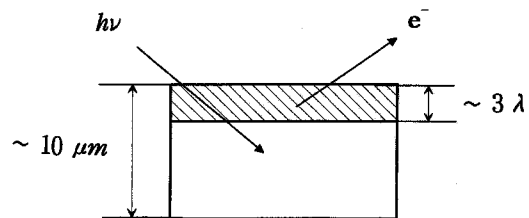


그림 2. 광전자 분광기술이 표면에 민감한 이유를 나타내는 그림. 빛은 시료 속 수 micron 까지 침투하여 광전자를 여기 시키지만 이 전자들이 시료 표면에 도달하기 전에 비탄성 충돌에 의해서 에너지를 잃으면서 가지고 있던 정보를 잃어버리기 때문에 오직 표면 근처에서 튀어나온 전자만 유용한 정보를 전달한다.

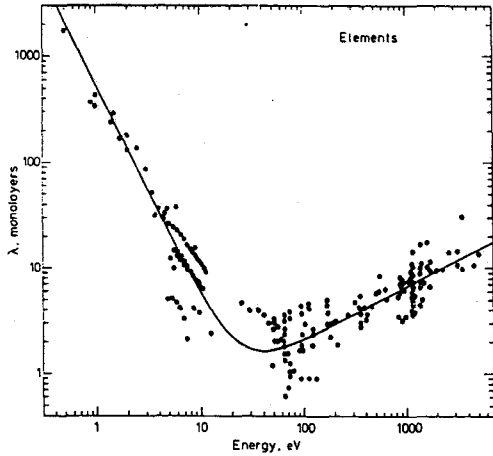


그림 3. 다양한 원소의 경우 전자의 에너지에 따른 평균자유행로를 표시한 그림. 상당히 벗어나는 점들이 많이 있지만 하나의 커브로 대략적으로 근사할 수 있으며, 이것을 universal curve라고 부른다.

Resonance Line	Energy (eV)	Intensity (%)
He I	21.2175	100
	23.0865	2
He II	40.8136	
Ne I	16.6704	15
	16.8474	100
Ar I	11.6233	100
	11.8278	50
Kr I	10.0321	
	10.6434	
Xe I	8.4363	
	9.5695	

그림 5. 방전 가스의 종류에 따라서 방전되면서 발생하는 빛의 에너지 변화를 보여주는 표. He II 방전은 중성 He이 아니라 He⁺가 방전 가스로 작용할 때 나타나는 빛이다.

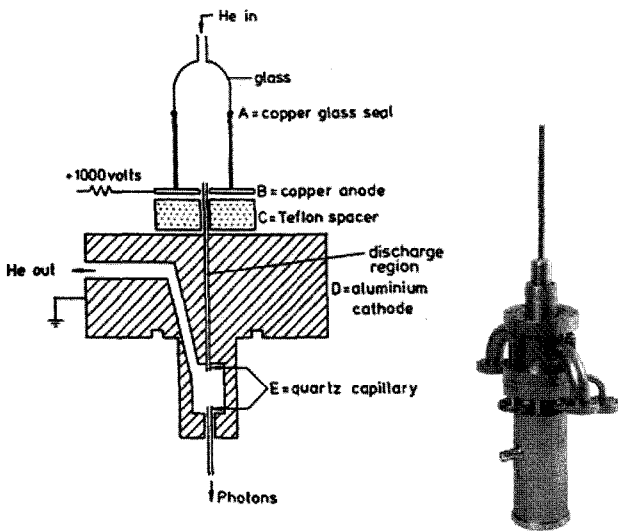


그림 4. 약 10~20 eV 정도의 단일 파장 빛을 발생시키기 위해서 사용되는 방전 램프. 방전램프 내부와 빛이 도달하는 진공용기 내부의 시료사이의 압력 차이를 유지하기 위해서 빛은 잘 통과하지만 방전 가스는 지나가기 힘들 모세관을 방전이 일어나는 구역과 시료 사이에 두고, 시료로 흘러 들어가는 가스를 펌프로 뽑아낸다.

을 수 있는 방법이 존재하지 않는다. 따라서 진공 용기 안에서 빛을 발생시키는 것이 유일한 방법이다. **그림 4**에 보인 것은 이러한 목적으로 널리 사용되는 UV 방전 램프의 단면도이다. 불활성 가스를 적당한 압력으로 램프 내부에 채워 넣고 2 kV 정도의 전압을 가하면 방전이 일어나면서 에너지가 잘 정의된 XUV 파장의 빛을 얻을 수 있다. 이때의 가스 압력은 시료가 존재하는 진공 용기의 압력에 비해서 훨씬 높기 때문에 방전 램프와 시료 사이에 압력 차이를 유지해 줄 필요가 있는데, 차동 펌핑(differential pumping) 방법을 사용하여 방전램프 내부는 수 mTorr, 시료가 있는 진공용기 내부는 10⁻⁹ Torr를 유지할 수 있다. 방전 램프 내부에 채워 넣는 가스의 종류에 따라서 발생하는 XUV 빛의 에너지가 결정되는데, 이러한 상황을 **그림 5**에 보이고 있다. 많은 경우에 높은 에너지의 빛을 발생시키는 He 가스를 사용하면, 최근에는 단순한 가스 방전이 아니고 고주파 플라즈마를 발생시켜서 XUV 빛의 생성 효율을 비약적으로 향상시킨 램프도 선보이고 있다. 불활성 가스의 방전에 의해서 생성하는 빛은 그 선폭이 수 meV 에 불과해서 거의 이상적인 단색광이라고 할 수 있고, 비교적 손쉽게 실험실 내부에서 사용할 수 있기 때문에 널리 사용된다. 하지만, 빛의 에너지를 쉽게 바꿀 수 없다는 단점도 있기 때문에 방사광을 사용하여 UPS 실험을 수행하는 경우도 많다. **그림 6**에 포항 방사광 가속기의 빔라인 개략도와 가속기 저장 링의 전자 에너지에 따라서 방사광의 에너지에 따른 빛의 세기 변화를 보여주고 있다. 특히 포항 방사광이나 미국의 ALS처럼 undulator를 사용하는 제3세대 방사광 가속기에서 발생하는 빛은 지금까지 존재하는 그 어떤 장치로 만들어 내는 빛보다 강한 빛을 만들어 낸다.

의 운동에너지만 알려져 있을 때 대략적인 IMFP를 짐작할 때 많이 사용된다. 주어진 물질에 대해서 더 정확한 IMFP를 계산하는 방법도 존재하지만 여기서는 생략한다.

2.2 장비

기본적인 광전자 분광기술을 이용하기 위한 장비로는 시료에 쬐여주는 단일 파장의 광원, 튀어나오는 전자의 에너지를 분석하여 EDC를 만들어주는 에너지 분석기, 그리고 이들을 담은 진공용기 등이 필요한데, 여기서는 UPS를 중심으로 XUV 영역의 파장을 가지는 광원, 전자에너지 분석기에 대해서 각각 간단히 소개한다. 우선 약 10~20 eV 정도의 에너지를 가지는 빛을 발생하는 광원에 대해서 생각해 보면, 이 에너지의 빛은 시료가 들어 있는 진공용기에서 모두 흡수되거나 반사되기 때문에 진공용기 외부에서 내부로 넣

광원에서 발생된 빛이 시료를 쬐일 때 튀어나오는 전자를 에너지에 따라서 분석해주는 장치가 전자에너지 분석기 인데, 광전자분광 장비의 핵심이라고 할 수 있다. 전자에너지 분석기는 다양한 종류가 존재하는데, **그림 7**에 보인 것이 가장 널리 사용되는 hemispherical sector analyzer (HSA) 혹은 concentric hemispherical analyzer (CHA)라고 불리는 것이다. 이 분석기는 그림에서 볼 수 있듯이 같은 중심을 가지는 두 개의 반구를 겹쳐 놓은 형태로 되어 있는데, 두 반구 사이에 전압을 걸어주고 입구 렌즈 쪽으로 전자가

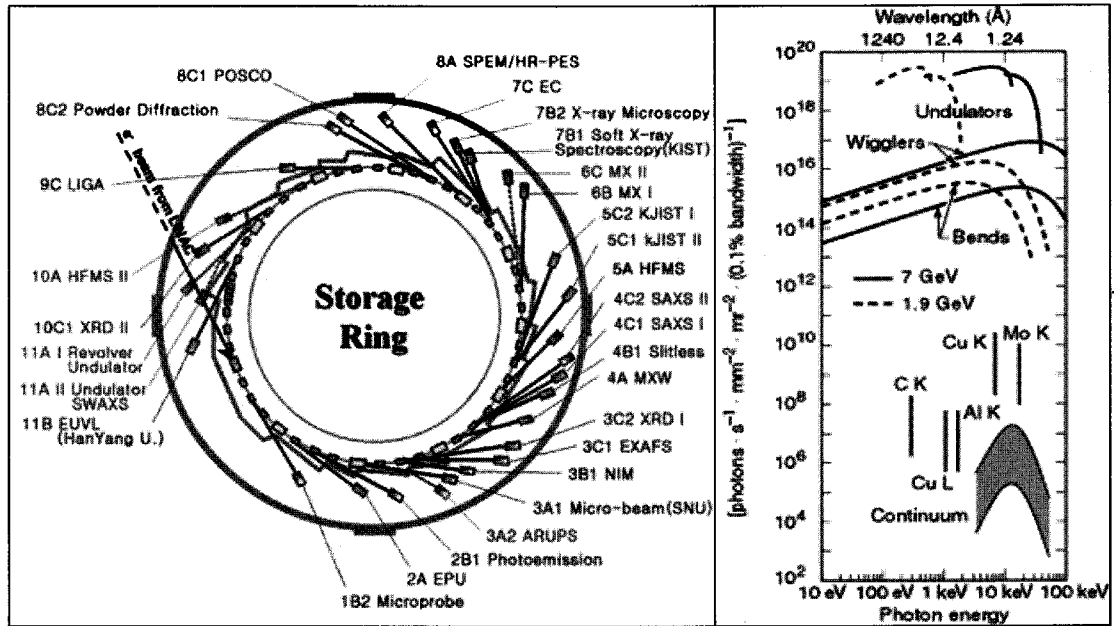


그림 6. (좌) 포항방사광 가속기의 저장링과 빔라인의 개략도. Bending magnet 빔라인과 undulator 빔라인이 섞여 있다. (우) 현존하는 방사광 가속기에서 발생할 수 있는 빛의 세기와 에너지 관계를 나타내는 커브들. y 축이 log scale인 점을 감안하면 방사광에서 발생하는 빛의 천문학적으로 강하다는 것을 알 수 있다.

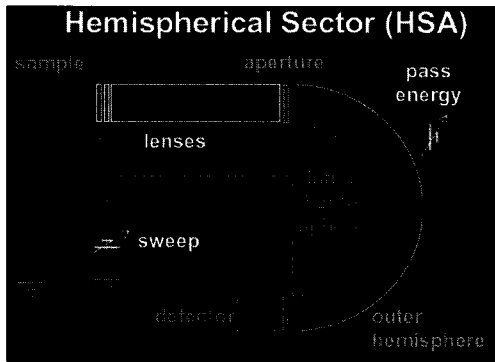


그림 7. 가장 널리 사용되는 HSA(혹은 CHA) 형태의 전자에너지 분석기의 개념도. 시료에서 방출된 전자는 렌즈 시스템으로 들어가서 적절히 집속된 후에 두 개의 반구 사이의 공간으로 입사한 후에 가해진 전압에 따라서 특정한 운동 에너지를 가진 전자만 검출기에 도달 할 수 있다. 걸여주는 전압을 바꾸면 전자의 운동에너지에 따른 세기를 측정하여 EDC를 얻을 수 있다.

들어오면 걸여준 전압에 해당하는 에너지를 가지는 전자만 출구 검출기에 도달할 수 있고, 다른 전자들은 모두 안쪽 반구 혹은 바깥쪽 반구에 부딪혀 사라진다. 두 반구 사이에 걸여주는 전압을 바꿔주면서 검출기에 기록되는 전자의 개수를 측정하면 EDC를 얻을 수 있다. 전자의 운동에너지에 따른 투과(transmission)를 일정하게 유지기 위해서 일반적으로는 CHA를 constant pass energy 모드에서 사용하는데, 이를 위해서는 두 개의 반구와 입구 렌즈, 그리고 입구 렌즈와 반구 사이에 존재하는 그리드(grid) 사이에 좀 더 복잡한 전압 배분이 필요하지만, 기본적인 원리는 동일하다. 그림 8에 보인 것은 최근에 들어서 사용되기 시작한 첨단 CHA의 개념인데, 넓은 면적의 검출기를 사용하여 검출기의 위치에 따른 전자의 세기를 측정(position sensitive detection)할 수 있다면 두 반구 사이에 걸여주는 전압을 고정하고 있어도 그림에서 'Energy'로 표시한 방향으로 에너지에 따른 전자의 세기를 측정할 수 있다. 이

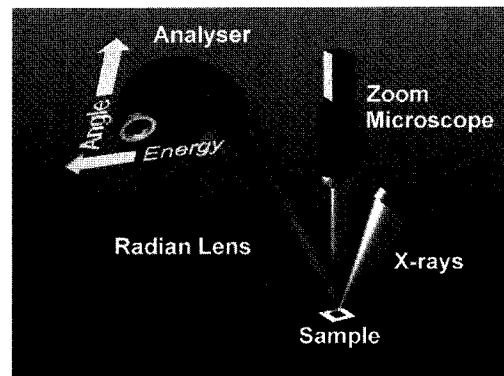


그림 8. 가장 최근에 개발된 이차원 전자위치 검출기와 CHA를 조합하면 시료의 각도를 바꾸거나 분석기의 반구에 걸리는 전압을 변화시키지 않고도 일정한 범위 내에서 에너지와 각도에 따라서 변화하는 전자의 세기를 얻을 수 있다.

때 얻을 수 있는 에너지 폭은 여러 가지 파라미터에 의해서 정해지는데 보통 수 eV 정도의 폭을 얻을 수 있으며, 경우에 따라서는 이 정도의 에너지 폭이면 충분한 경우도 있다. 또한 검출기의 'Energy' 방향과 수직인 방향으로 시료표면에서 다양한 각도로 방출되는 전자를 각도에 따라서 검출하는 것이 되는데 그림 8의 'Angle'에 해당하는 방향이다. 이와 같은 에너지 분석기와 대면적 검출기를 사용하면, 전압이나 시료 각도의 변화 없이 에너지와 각도에 따른 전자의 세기를 검출할 수 있다. 결정성 고체의 경우는 이것이 바로 밴드 구조에 해당하는 것이므로, 최근 들어서는 UPS를 사용한 밴드 매핑(band mapping)이 예전에 비해서 훨씬 쉬워졌다. 그림 9에 이런 방법으로 검출된 graphene sheet의 밴드 구조를 보이고 있다.¹

2.3 에너지 레벨 정렬 측정

단결정 시료가 아닌 경우, 특히 고분자나 비정질 분자고체(amorphous molecular solid) 시료의 경우에는 밴드 매핑은 의미가 없고,

다만 물질의 에너지 레벨을 UPS를 이용하여 측정하는 것이 유용한 정보를 제공한다. 특히 유기물과 금속의 계면과 같이 서로 다른 물질이 접합을 이루고 있을 때는 각각의 물질 에너지 레벨의 상대적 위치가 전하의 주입과 같은 성능에 큰 영향을 미치기 때문에 이들을 측정하는 것이 대단히 중요하다. **그림 10**에 보인 것은 PPV 계열의 고분자 시료를 He I UPS를 이용하여 측정한 스펙트럼을 보여주고 있다. 그림에서 x 축의 영(zero)은 시료의 페르미 준위

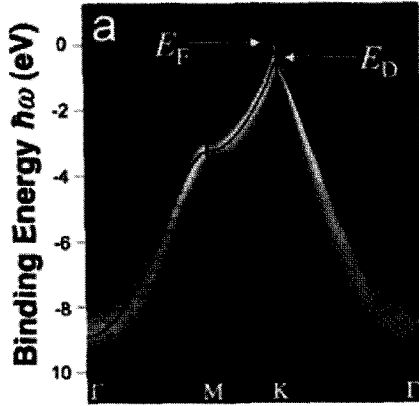


그림 9. 그림 8에서 예시한 것과 유사한 전자 에너지 분석기를 이용하여 원자 층 한 두 개 정도로 얇은 graphene sheet에서 측정한 밴드 구조. 이런 그림은 불과 몇 년 전만 하더라도 고체결정의 양자 계산에 의해서만 얻을 수 있었는데, 이제는 실험 데이터를 손쉽게 얻을 수 있게 되었다.

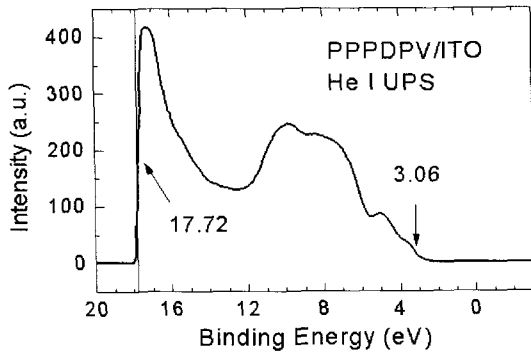


그림 10. PPV의 유도체인 고분자 물질에서 측정한 전형적인 UPS 스펙트럼을 보이고 있다. Binding energy 기준은 페르미 준위이며, 이를 중심으로 HOMO의 위치와 진공 에너지 준위의 상대적 위치를 측정할 수 있다.

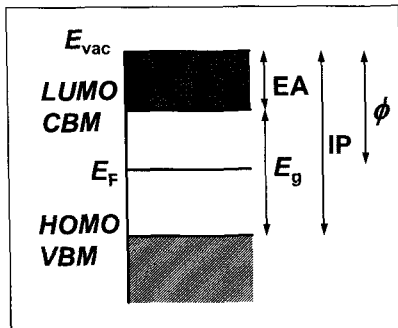


그림 11. 고체 혹은 분자의 가전자 근처의 다양한 에너지 레벨을 나타내는 그림. 붉은 색으로 표시한 값들은 광전자 분광을 이용해 측정할 수 있는 것들이고, 푸른색은 다른 방법을 이용해서 측정해야만 하는 값들이다.

(E_F)이고 3.06 eV로 표시한 부분이 이 물질의 HOMO (highest occupied molecular orbital) 혹은 VBM (valence band maximum)을 나타낸다. 따라서 이 스펙트럼으로부터 HOMO/VBM 상대적 위치를 알 수 있다. 또한 17.72 eV로 나타낸 부분은 진공준위(vacuum level)에 의해서 나타나는 E_{cutoff} 로서, 이로부터 다음 식에서 시료의 일함수(work function)를 알 수 있다.

$$\phi = h\nu - |E_{cutoff} - E_F| \quad (3)$$

따라서 UPS를 이용하면 가전자 준위 근처에 있는 중요한 에너지 준위들을 알 수 있는데, 이를 **그림 11**에 나타내고 있다. 여기서 LUMO(lowest unoccupied molecular orbital)나 CBM(conduction band minimum)은 알 수가 없는데, 역광전자 분광기술(inverse photoemission)을 이용하여 직접 측정하거나 HOMO-LUMO 에너지 갭(energy gap)을 측정하여 LUMO의 상대적 위치를 알 수 있다. **그림 11**에 보였듯이 진공 준위 E_{vac} 과 LUMO의 에너지 차이를 electron affinity(EA)라 하고, E_{vac} 과 HOMO의 차이를 ionization potential(IP)이라고 한다. 다음 절에서 이러한 에너지 준위의 정렬 측정이 유기 EL 소자 계면에서 나타나는 전하주입에 어떤 영향을 주며, 계면의 화학상태 변화나 계면 쌍극자 층의 형성에 의해서 어떻게 변화하는지 다음 절에서 살펴보자.

3. 유기/금속, 유기/유기 계면의 에너지 정렬

여기서는 주로 유기 EL 소자에서 관찰할 수 있는 다양한 형태의 계면에서 에너지 정렬을 포함하여 나타나는 여러 가지 전기적 화학적 변화를 UPS 및 XPS를 사용하여 연구한 내용들 중 일부를 예로 들어서 설명기로 하겠다. 이미 잘 알려진 것처럼 통상의 유기 EL 소자는 **그림 12**에서 볼 수 있듯이 여러 층의 유기물질로 이루어져 있는데, 각각의 두께가 수십 nm 정도 되어서 총 두께는 수백 nm 이

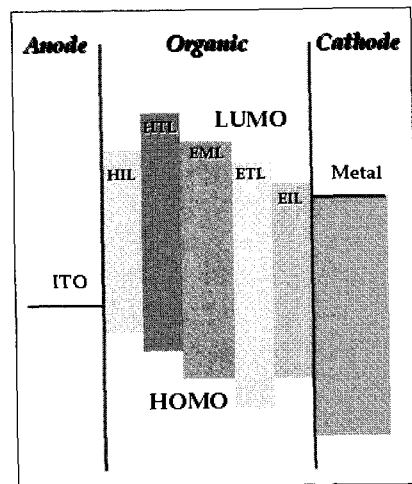


그림 12. 유기EL 소자의 다층구조와 각각 물질의 HOMO와 LUMO 에너지 위치를 나타내는 그림. 양극 및 음극을 이루는 금속 물질의 일함수와 유기물의 HOMO 및 LUMO 사임의 에너지 차이는 전자 및 정공의 주입에 큰 영향을 미치며, 유기물과 유기물 사이의 에너지 차이는 발광층(EML)에 전자와 정공이 모이도록 하는데 지대한 영향을 준다.

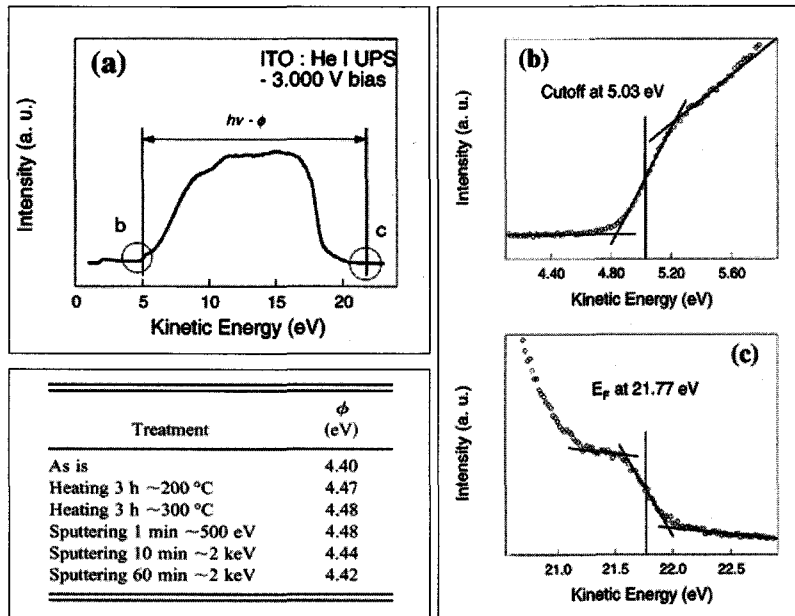


그림 13. 광전분광 기술을 이용하여 ITO의 일함수를 측정하는 것. UPS를 사용하면 손쉽게 일함수를 측정할 수 있으며, 이 경우에는 약간의 스퍼터링이나 가열에 대해서 ITO의 일함수가 크게 변하지 않음을 알 수 있다.

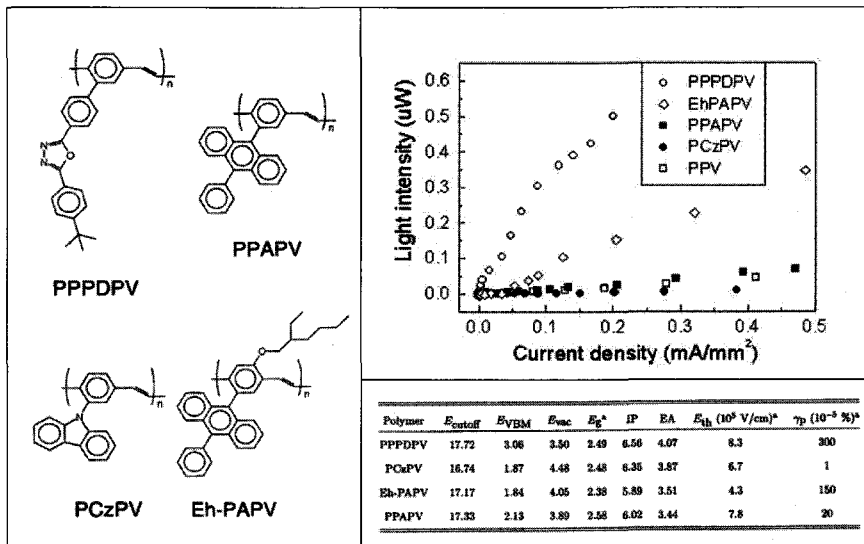


그림 14. 그림의 왼쪽에 보인 몇 가지 PPV 유도체를 이용하여 단일 층 유기 EL 소자를 제작하여 그 성능을 측정하는 그림이 오른쪽 위 그림이다. PPPDPV 고분자로 만든 소자의 성능이 월등함을 알 수 있는데, 이러한 현상의 원인을 UPS를 사용한 에너지 준위의 상대적 정렬로 설명할 수 있다. 오른쪽 아래 표에서 PPPDPV 소자의 경우에 전자 주입 장벽이 가장 낮음을 알 수 있다.

다. 그림에서 보인 것은 양극(anode)과 음극(cathode)로 구성된 전극의 일함수와 각 유기물 층의 HOMO 및 LUMO 정렬 상태를 보이고 있다. 양극에서부터 HIL(hole injection layer), HTL(hole transport layer), EML(emission layer), ETL(electron transport layer), EIL(electron injection layer) 등으로 이루어져 있으며, 이들 중 일부는 뒤에서 볼 수 있듯이 유기물이 아닌 경우도 있다.

유기 EL 소자의 양극 접합에서 가장 중요한 요소는 양극에서 유기물 층으로 정공(hole)이 얼마나 잘 주입될 수 있는가 하는 것이고, 이것은 양극을 이루는 물질의 일함수가 클수록 유리하다. 양극 물질은 보통 전기를 잘 통하면서 유기 EL 소자에서 나오는 가시광선 영역의 파장을 가진 빛을 투과할 수 있어야 하기 때문에 ITO

(indium-tin oxide)가 널리 사용된다. 일반적으로 ITO 박막은 표면처리 방법에 따라서 일함수가 크게 달라질 수 있기 때문에 표면처리 방법에 따른 정확한 일함수 측정이 중요함을 말할 나위가 없다. 그림 13에서 ITO의 일함수를 간단한 가열 혹은 가벼운 Ar 이온빔 스퍼터링에 따라 변화하는 일함수를 측정하는 예를 보이고 있다.² 여기서 사용한 방법에 의해서는 일함수에 큰 변화가 없는 것으로 나타나고 있으나, 산소 플라즈마 처리, 혹은 UV 오존 처리를 하는 경우 표면의 오염이 세정되고, 충분한 산화가 이루어지면서 일함수가 크게 변화되는 양상을 보이기도 한다. 사실 UPS를 사용한 표면의 일함수 측정은 다양한 시료에 대해서 적용이 가능하며 입사하는 He I XUV 빛의 에너지(21.22 eV)를 정확히 알고 있으면 손

쉽게 계산할 수 있기 때문에 널리 사용되고 있다. 일함수를 측정하는 다른 방법으로는 특정한 전극(e.g. Au)에 대해서 상대적인 일함수를 측정할 수 있는 Kelvin probe가 있으나 UPS에 비해서 측정상의 어려운 점이 있어서 널리 사용되지 못하고 있다.

그림 14에 보인 것은 몇 가지 PPV 유도체의 화학 구조와 함께 이들 고분자를 사용하여 만든 단일 층(single layer) 유기 EL 소자의 전기적 특성을 보이고 있다. 또한 앞서 설명한 방법으로 측정된 IP 및 EA 값을 표에서 보이고 있다. 이러한 UPS 측정을 통해서 PPPDPV로 명명된 고분자를 사용한 유기 EL 소자의 성능이 다른 경우에 비해서 획기적으로 향상된 것은 음극에서 고분자 물질로 전자가 주입될 때 나타나는 에너지 장벽이 현저하게 낮기 때문이라는 것을 알 수 있었다.³⁻⁵ 이처럼 UPS를 사용하면 전자 혹은 정공이 음극이나 양극에서 주입될 때 만나게 되는 에너지 장벽의 높이를 알 수 있을 뿐만 아니라 유기물과 금속이 접합을 이루면서 나타나는 화학적 변화나 전자 이동과 같은 현상을 민감하게 측정할 수 있다. **그림 15**에 그와 같은 예를 보이고 있다. 여기서는 PPV의 올리고머 형태로 그림에 보인 것처럼 4PV라 명명한 분자를 진공에서 증착하여 약 30 nm 정도의 박막을 형성하고 이때 photoluminescence(PL)를 측정하면 이 물질로 만든 유기 EL 소자에서 나오는 것과 동일한 분광 스펙트럼을 얻을 수 있다. 그런데, 낮은 일함수로

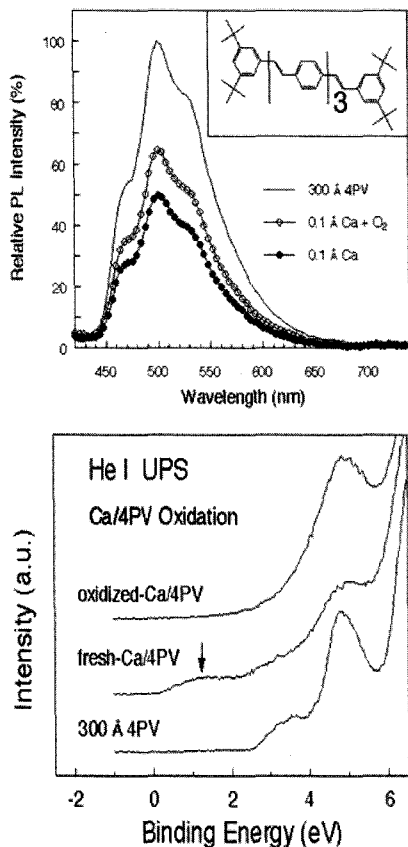


그림 15. PPV의 soluble oligomer 형태라고 할 수 있는 4PV의 박막에서 PL 스펙트럼을 얻었고, 여기에 약간의 Ca를 증착하면 PL이 급격히 quenching 된다는 것을 알 수 있다. 특히 PL quenching은 UPS 스펙트럼에서 gap state의 출현과 동시에 발생하는 것을 알 수 있는데, 엑시톤이 gap state에 의해서 소멸되어서 이와 같은 현상이 나타난다. Ca를 산화 시켜서 gap state를 없애면 PL quenching도 부분적으로 사라진다.

인해서 유기 EL 소자의 음극 물질로 많이 사용되는 Ca를 4PV 박막 위에 증착하면 극히 약간만 증착하여도 PL 스펙트럼의 세기가 50% 이상 감소하는 것을 관찰할 수 있다. 이때 UPS 스펙트럼을 측정하면 Ca를 증착한 경우 그렇지 않은 경우의 4PV 스펙트럼에 비해서 새로운 피크가 생긴 것을 쉽게 관찰할 수 있다. Ca가 증착된 4PV 박막을 산소 분위기에 잠시 노출시켜서 Ca를 산화 시키면 PL 스펙트럼의 세기는 다시 증가하고 UPS 스펙트럼에 보이던 새로운 피크도 사라지는 것을 관찰할 수 있었다. 이러한 변화의 원인은 Ca에서 쉽게 떨어져 나온 전자가 4PV를 doping 하여 새로운 피크(gap state)를 만들고, 이러한 gap state가 빛을 내는데 필수적으로 형성되어야 하는 엑시톤(exciton)의 해리(dissociation)을 촉진하기 때문이다.⁶⁻⁸

저분자를 사용하는 유기 EL 소자는 통상 Alq₃와 음극을 이루는 금속 물질이 접합을 이루는 경우가 많다. 이때 사용되는 금속이 Ca, Mg, Li 같은 낮은 일함수를 가지는 물질이면 소자가 뛰어난 성능을 보인다는 사실은 낮은 일함수가 음극과 유기물 사이의 전자주입 장벽을 낮춰줄 수 있다는 점을 상기하면 비교적 쉽게 이해할 수 있는 일이다. 금속들 중에서 일반 Si 소자에 많이 사용되고 나노 수준에서 패터닝이 쉽지만 일함수가 중간정도 밖에 되지 않는 Al을 음극으로 사용하는 경우에 유기 EL 소자의 효율이나 안정성이 크게 떨어진다라는 사실도 알려져 있다. 그런데, Al 음극과 유기물 사이에 LiF 나 MgO와 같은 무기물 층을 0.5~1.0 nm 정도의 두께로 얇게 삽입하면 소자의 성능과 안정성이 비약적으로 향상된다는 사실이 알려지게 되었다.⁹ 강력한 부도체로 알려진 이러한 물질들이 유기물과 음극 금속 사이에서 어떤 역할을 하는지 많은 논란이 있었지만 아직도 모든 경우에 명확하게 알려지지 않고 있다. **그림 16**에 보이는 것은 Alq₃ 위에 LiF와 NaF를 각각 조금씩 증착하여 약 0.5 nm 두께가 되도록 하고, 그 위에 Al을 조금씩 증착하면서 HOMO 부근의 전자 에너지 준위들이 변화하는 양상을 측정해본 것이다.¹⁰ 처음에 LiF/NaF를 증착하는 도중에는 HOMO 준위가 더 큰 결합에너지(binding energy, BE) 방향으로 움직이는 것을 뚜렷이 관찰할 수 있으며, LiF/NaF가 증착된 후에 Al을 추가로 증착하는 경우에는 HOMO 준위의 움직임은 더 이상 관찰되지 않고 새로운 에너지 레벨이 HOMO 준위와 페르미 준위 사이의 BE에서 새로이 발달되는 것을 관찰할 수 있다. 이러한 현상은 LiF/NaF의 역할이 계면 쌍극자의 형성이나 다른 화학적 작용에 의해서 HOMO의 에너지 준위를 전자가 주입되기 쉬운 방향으로 이동시키는 것이라는 사실을 극명하게 보여주고 있다. 또한 Al의 증착에 의해서 발달되는 gap state는 일단 LiF나 NaF가 존재하는 경우에는 HOMO 준위의 움직임에 별다른 역할을 하지 못한다는 사실도 분명히 알 수 있다.

4. 결론

본 총설에서 살펴본 것은 UPS로 대변되는 광전자 분광기술이 유기물의 전자 에너지 준위와 유기물과 다른 물질 사이의 계면에서 나타나는 화학반응 및 전자 에너지 준위의 변화를 측정하여, 실제 유기물 전자소자에서 중요한 전자 및 정공의 주입 장벽에 따른 성능 예측에 도움을 줄 수 있다는 측면이다. 이러한 응용에 있어서 광전자 분광기술은 대단히 유용한 정보를 제공해 왔고, 앞으로도 더 쉽고 빠르게 이러한 정보를 다양한 물질에 대해서 제공할 수 있을 것

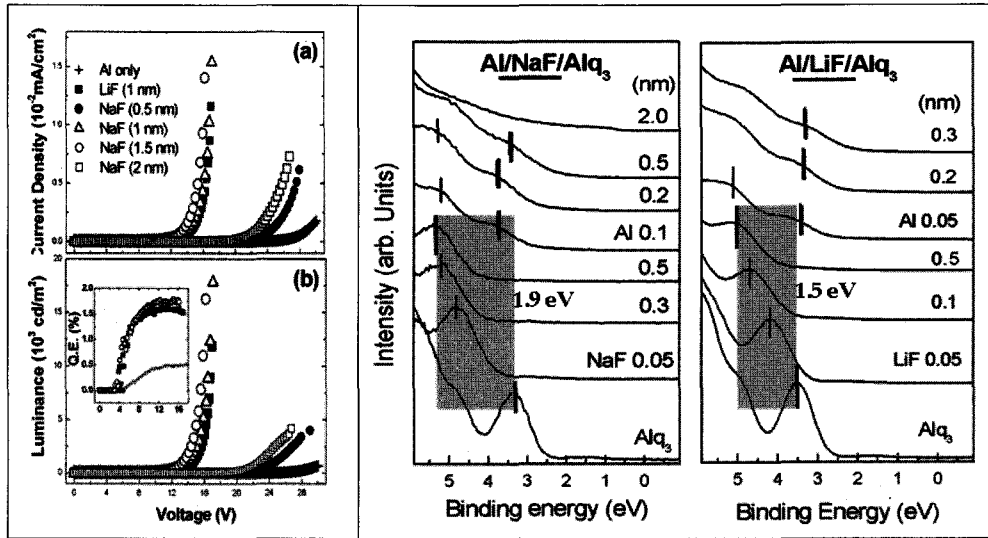


그림 16. 대표적 유기EL 소자에서 음극 구조를 Al/LiF/Alq₃ 및 Al/NaF/Alq₃로 하였을 때 관찰되는 소자의 성능 향상 및 UPS 스펙트럼의 변화. LiF 혹은 NaF를 증착하면 HOMO 준위가 높은 binding energy 쪽을 움직여서 Al에서 유기물의 LUMO로 전자를 주입하는 장벽을 낮추어 주기 때문에 소자의 성능이 향상된다.

으로 기대된다. 한편, 광전자 분광기술은 그 적용 범위가 대단히 넓은 기술로써 계면의 에너지 준위 정렬뿐만 아니라, 약간의 변형을 통해서 유기 고분자 물질의 표면과 계면에서 더욱 다양한 정보를 얻을 수 있다. 예를 들어서 앞서 짧게 언급한 역광전자 분광 기술을 적용 하면 빈전자상태(empty state)의 에너지 레벨을 측정할 수 있고, 방사광을 이용하여 XUV 혹은 X-선의 에너지를 연속적으로 변화시킬 수 있다면 XAS(X-ray absorption spectroscopy), NEXAFS (near-edge X-ray absorption fine structure) 등을 이용해서 코어전자와 빈전자 상태 사이의 전자 전이를 통해서 빈전자상태에 대한 정보를 얻을 수 있다. 뿐만 아니라 극초단 레이저 펄스를 이용해서(에너지가 3.1 eV 정도 되는 빛으로 시료의 전자를 여기 상태로 보낸 후 또 하나의 유사한 펄스를 이용해서 전자를 방출 시키면 여기 전자 상태의 시간에 따른 동력학을 측정할 수 있는 가능성이 있다. 최근에는 이러한 시분해 광전자 분광기술(time-resolved 2 photon photoemission)의 높은 시간 분해능(수 fs)을 이용하여 금속 전극에서 고분자나 저분자 유기 물질로 전자가 이동한 후에 anion 상태가 안정화 되는 과정을 시간에 따라서 추적할 수 있는 측정 기술이 개발되기도 했다.

광전자 분광 및 관련 기술은 다시 한 번 강조하지만 전자재료용 유기물질 및 소자 계면에서 일어나는 다양한 전자 현상들을 측정할 수 있는 강력한 도구이며, 앞으로도 더욱 다양한 방향으로 발전될 수 있는 실험 방법이다.

참고문헌

1. Ohta, *et al Science*, **313**, 951 (2006).
2. Park, *et al., Appl. Phys. Lett.*, **68**, 2699 (1996).
3. Park, *et al., J. Korean Phys. Soc.*, **37**, 59 (2000).
4. Lee, *et al., Chem. Mater.*, **13**, 565 (2001).
5. Chung, *et al., Adv. Mater.*, **10**, 1112 (1998).
6. Park, *et al., Phys. Rev. Lett.*, **78**, 3955 (1997).
7. Choong, *et al., Appl. Phys. Lett.*, **69**, 1492 (1997).
8. Choong, *et al., Appl. Phys. Lett.*, **71**, 1005 (1997).
9. Hung, *et al., Appl. Phys. Lett.*, **70**, 152 (1997).
10. Lee, *et al., Appl. Phys. Lett.*, **82**, 137 (2003).